



公益社団法人応用物理学会 先進パワー半導体分科会 第6回講演会



先進パワー半導体分科会
Advanced Power Semiconductors

開催日 : 2019年12月3日(火)~4日(水)

開催場所 : 広島国際会議場 (広島平和公園内、平和記念資料館本館の西隣)

〒730-0811 広島県広島市中区中島町1-5

基調講演(敬称略)

木本 恒暢 (京都大学)

「ワイドギャップ半導体パワーデバイスの発展と展望」

マジュムダール ゴーラブ (三菱電機株式会社)

「Si IPMの開発経緯とパワーデバイスの今後の動向」

特別講演

伊藤 孝浩 (トヨタ自動車株式会社)

「車載用パワーデバイス/パワーエレクトロニクスの進展」

小川 徹 (JAEA廃炉国際共同研究センター)

「福島第一原子力発電所廃炉を支える基礎基盤研究開発」

招待講演

岩室 憲幸 (筑波大学)

「SiC-MOSFETの負荷短絡耐量特性の解析」

金子 純一 (北海道大学)

「ダイヤモンド放射線検出器とダイヤモンドFETを用いた
前置増幅器の開発」

喜多 浩之 (東京大学)

「4H-SiCの水蒸気酸化反応の特徴と
そのMOS界面特性に与える効果の理解」

佐々木 公平 (ノベルクリスタルテクノロジー株式会社)

「β型Ga₂O₃のエピタキシャル成長とパワーデバイス応用」

島 明生 (株式会社日立製作所)

「極限環境IoTに向けたSiC集積回路の研究」

菅沼 克昭 (大阪大学)

「WBGパワーデバイスのための耐熱実装技術」

田中 保宣 (産業技術総合研究所)

「SiCによる耐放射線エレクトロニクス技術開発」

土田 秀一 (電力中央研究所)

「高電圧パワーデバイスに向けた4H-SiC CVD成長技術の進展」

寺島 知秀 (三菱電機株式会社)

「パワーデバイス性能向上に伴う自己発熱の影響とその対策」

中村 孝 (大阪大学/ 福島SiC応用技研)

「SiCを用いた超高電圧機器開発と医療分野への応用」

山田 英明 (産業技術総合研究所)

「ダイヤモンド単結晶基板の作製技術開発の現状」

吉持 賢一 (ローム株式会社)

「GaNパワーデバイスの開発・技術・市場動向」

奨励賞受賞講演

鐘ヶ江 一孝 (京都大学)

「光過渡容量分光法によるn型GaN中の
正孔トラップ密度の高速かつ精密定量手法」

中島 誠志 (京都大学)

「高温動作集積回路を目指したノーマリオフ型p-JFET
およびn-JFETの同一SiC基板上への作製」

募集

ポスター講演(一般講演)

優れた研究成果を積極的にアピールした
若手研究者に研究奨励賞を贈賞します

募集

企業展示 60小間
(90,000円/小間)

講演会参加費

| | 事前 | 当日 |
|---------|--------|---------|
| 分科会会員 | 4,000円 | 6,000円 |
| 一般 | 8,000円 | 10,000円 |
| 分科会学生会員 | 2,000円 | 3,000円 |
| 学生一般 | 3,000円 | 4,000円 |

実行委員会

実行委員長

黒木 伸一郎 (広島大学)

実行委員

東 清一郎 (広島大学)

瀬崎 洋 (フェニテックセミコンダクター)

寺本 章伸 (広島大学)

中田 洋輔 (三菱電機)

花房 宏明 (広島大学)

原田 俊太 (名古屋大学)

藤井 敬久 (マツダ)

事務局

五十嵐 周 (応用物理学会)

詳細はこちら

<http://annex.jsap.or.jp/adps/scrm06/index.html>

お問い合わせ先 : 応用物理学会分科会担当 igarashi@jsap.or.jp

